

Liste des Communications

Exposés Invités	23
A Mercredi 9 Juin 2004	23
A.1 C. Sirtori, A. Vasanelli, S. Dhillon, X. Marcadet, V. Ortiz, L. Lanco, S. Ducci, M. Calligaro, A. De Rossi, B. Vinter, J. Nagle, V. Berger <i>Nouvelles sources optiques semiconductrices : lasers à cascade quantique, génération d'onde THz, sources de photons jumeaux.</i>	25
A.2 S. Bollaert, J.-S. Galloo, Y. Roelens, X. Wallart, A. Cappy <i>Composants balistiques</i>	27
A.3 C. Chappert, V. Sousa <i>Mémoires non volatiles magnétiques et à changement de phase</i>	29
A.4 W. Knap, J. Lusakowski, F. Teppe, N. Diakonova, Y. Meziani, T. Parenty, S. Bollaert, A. Cappy, Y. Deng, S. Rumyantsev, M. S. Shur <i>Génération et détection de radiation Térahertz par les ondes plasma dans les transistors nanométriques</i>	31
A.5 J. Mangeney, L. Duvallet <i>Échantillonnage électro-optique : application aux circuits télécoms très haut débit et à la compatibilité électromagnétique</i>	33
A.6 F. Julien <i>Nanostructures GaN/AlN pour l'optoélectronique aux longueurs d'onde télécoms</i>	35
A.7 J.-L. Reverchon, M. Mosca, N. Grandjean, F. Omnes, F. Semond, J.-Y. Duboz <i>Photodétecteurs UV à base GaAlN</i>	37
B Jeudi 10 Juin 2004	39
B.1 B. Jouault, B. Chenaud, M. Gryglas, M. Baj, G. Faini, A. Cavanna <i>Transport tunnel résonnant à travers une impureté unique</i>	41
B.2 A. Bachtold, B. Bourlon, C. Glattli, C. Miko, L. Forro <i>Épluchage de nanotubes multi-feuillets</i>	43
B.3 T. Baron, A. Filoramo <i>Manipulation, localisation, organisation, contact de nanoobjets (nanotubes et molécules d'ADN)</i>	45
B.4 L. Nicu <i>Micro et Nanosystèmes à structures mécaniques mobiles pour le dépôt et la détection de biomolécules</i>	47
B.5 J.-J. Greffet, F. Marquier, S. Collin, F. Pardo, J.-L. Pelouard <i>Propriétés électromagnétiques des réseaux métalliques</i>	49
B.6 C. Seassal <i>Intégration photonique hétérogène III-V/Silicium</i>	51
B.7 G.-H. Duan <i>Cristaux photoniques pour optoélectronique III-V : les enseignements de démonstrateurs</i>	53
C Vendredi 11 Juin 2004	55
C.1 M. Vinet <i>Transistors à double grille</i>	57
C.2 R. Lefèvre, F. Dispérati, V. Rodrigues, D. Baillargeat, B. Thon, J. Hourany, J. Moron, C. Aupetit, J.-M. Dumas, D. Grot, E. Pincemin <i>Modules intégrés d'émission/réception 40 Gbit/s et transmission sur 300 km : projet RNRT ERMIONE</i>	59

C.3	S. Bouchoule, G. Almuneau <i>VCSELS 1,55 μm en pompage électrique</i>	61
C.4	R. Teissier, D. Barate, A. Vicet, C. Alibert, A. Baranov, C. Sirtori, C. Renard, X. Marcadet <i>Lasers à cascade quantique InAs/AlSb</i>	63
C.5	B. Sagnes, F. Saigné, T. Merelle, J.-M. Palau, G. Bruguier, J.-F. Carlotti, C. Guasch, J. Bonnet <i>Évaluation du taux d'erreurs dans les composants microélectroniques dû aux effets des radiations en environnement terrestre</i>	65
C.6	O. Llopis <i>Bruit en régime linéaire et non-linéaire dans les composants et circuits de télécommunications</i>	67
Session Poster I		71
A	Croissance épitaxiale des semiconducteurs	71
A.1	P. Caroff, N. Bertru, O. Dehaese, A. Le Corre, T. Rohel, A. Ponchet <i>Contrôle de la longueur d'onde d'émission d'îlots quantiques InAs/InGaAsP/-InP(311)B réalisés par épitaxie par jets moléculaires</i>	73
A.2	A. Dussaigne, N. Grandjean, B. Damilano, J. Massies <i>Étude du GaN de type p à travers les caractéristiques de jonctions p-n</i>	75
A.3	S. Joblot, F. Semond, F. Natali, E. Feltin, F. Omnes, Y. Cordier, E. Beraudo, M. Laügt, P. Vennegues, J. Massies <i>Croissance de GaN par MBE et MOCVD sur Si(100)</i>	77
A.4	C. Renard, X. Marcadet, I. Prévot, R. Bisaro, P. Galtier, J. Massies <i>Étude de la ségrégation de surface de l'Indium dans les hétérostructure AlSb et GaSb réalisées par EJM</i>	79
A.5	D. Barate, R. Teissier, A. Baranov, C. Alibert <i>Réalisation par EJM de lasers à cascade quantique dans le système InAs/AlSb</i>	81
A.6	A. Matsuse, N. Grandjean, J. Massies <i>Nouvelle méthode de formation de boîtes quantiques de GaN par épitaxie par jets moléculaires utilisant une source ammoniac</i>	83
A.7	G. Delhay, S. Gaillard, M. Gendry, G. Hollinger, Y. Robach <i>Épitaxie de SrO sur SrTiO₃(001) et Si(001)</i>	85
A.8	V. Celibert, N. Chauvin, E. Tranvouez, C. Bru-Chevallier, G. Guillot, L. Grenouillet, P. Gilet, P. Duvaut, A. Million <i>Boîtes quantiques InAs/GaAs émettant 1,3μm : simple plan et empilements de plans</i>	87
A.9	R. Beneyton, P. Regreny, M. Gendry, G. Grenet, B. Canut, G. Hollinger <i>Sur l'incorporation du thallium dans InTlAs et GaTlAs élaborés par EJMSS</i>	89
A.10	M.-P. Besland, S. Le Tacon, P.-Y. Tessier, B. Angleraud, M. Richard, L. Brohan, J.-P. Landesman, M. A. Djouadi, <i>Dépôt par PVD magnétron d'oxydes ferroélectriques pour des applications en microélectronique</i>	91
A.11	Y. Cordier, M. Hugues, P. Lorenzini, F. Semond, F. Natali, Z. Bougrioua, S. Chenot, H. Haas, J. Massies <i>Mobilités et Caractéristiques I-V des HEMTs AlGaIn/GaN</i>	93
A.12	C. Blanc, M. Zielinski, S. Juillaguet, S. Contreras, J. Camassel, C. Sartel, V. Soulière, Y. Monteil, D. Tournier, P. Godignon <i>Problèmes technologiques liés au processus de fabrication de MOSFETs 4H-SiC orientés <11-20></i>	95
A.13	E. Tournié, N. Deguffroy, P. Christol, A. N. Baranov, P. Girard, M. Ramonda <i>Croissance et caractérisations de boîtes quantiques dans la filière GaSb</i>	97
B	Caractérisation structurale, optique et électrique des semiconducteurs	99
B.1	M. Leroux, F. Cadoret, F. Natali, F. Omnes, F. Semond, J. Massies, S. Laügt, L. Hirsch <i>Efficacité radiative de l'alliage Al_xGa_{1-x}N</i>	101

B.2	C. Palermo, L. Varani, J. Vaissiere <i>Étude hydrodynamique de l'influence des micro-ondes sur les processus de génération-recombinaison dans le HgCdTe</i>	103
B.3	H. Chouaib, C. Bru-Chevallier, H. Lahreche, P. Bove <i>Caractérisation optique d'hétérostructure GaAsSb/InP par la technique de Photo-réflexivité</i>	105
B.4	M. Zegaoui, J. Harari, V. Magnin, D. Decoster <i>Variation d'indice et d'absorption obtenus par effet plasma dans les hétérostructures InGaAsP/InP : Mesure à 1.3μm et à 1.55μm</i>	107
B.5	A. Penarier, S. Jarrix, D. Gasquet, C. Chay, C. Delseny, F. Pascal <i>Méthodes d'extraction de la résistance série d'émetteur de transistors bipolaires . . .</i>	109
B.6	S. Juillaguet, J. Camassel, V. Soulière, C. Sartel, Y. Monteil <i>Spectroscopie des fautes d'empilement dans 4H-SiC : de la micro-inclusion de polytype 3C à l'hétérojonction de type-II</i>	111
B.7	M. A. Belaid, H. Maanane, K. Mourgues, M. Masmoudi, K. Ketata, J. Marcon <i>Caractérisation électrothermique du transistor LDMOS RF de puissance</i>	113
B.8	C. Consejo, S. Contreras, L. Konczewicz, J.-L. Robert, P. Lorenzini, Y. Cordier, C. Skierbiszewski <i>Étude des propriétés électriques de l'hétérojonction GaN/AlGaIn en vue d'application à hautes températures</i>	115
C	Composants électroniques	117
C.1	E. Duraz, L. Duvillaret, P. Ferrari, J.-L. Coutaz, J.-P. Ghesquiers, E. Estebe <i>Caractérisation et modélisation entre 40 MHz et 114 GHz de diodes PIN monolithiques sur substrats SOI</i>	119
C.2	J. Saint Martin, A. Bournel, P. Dollfus <i>Étude du transport quasi-balistique dans les transistors MOSFETs à Double Grille ultra-courts</i>	121
C.3	P. Benoît, C. Chay, C. Delseny, F. Pascal, J. Vildeuil, H. Baudry. <i>Influence de la profondeur de la jonction émetteur-base sur le bruit basse fréquence des TBHs SiGe :C</i>	123
C.4	B. Grandchamp, C. Maneux, N. Labat, A. Touboul <i>Simulation physique des mécanismes de recombinaison d'un TBH InP/GaAsSb/InP</i>	125
C.5	N. Ismail, N. Malbert, N. Labat, A. Touboul, B. Lambert, J.-L. Muraro <i>Comparaison des lieux de claquage BV-on state des différentes technologies à substrat GaAs : MESFET, DCFET, PHEMT et PPHEMT</i>	127
C.6	A. Curutchet, N. Malbert, N. Labat, A. Touboul, M. Uren <i>Analyse du bruit basses fréquences de HEMTs AlGaIn/GaN sur substrat SiC et Saphir</i>	129
C.7	C. Chay, P. Benoît, C. Delseny, F. Pascal, R. Venegas <i>Étude du bruit basse fréquence dans les transistors bipolaires à hétérojonction Si/SiGeC</i>	131
C.8	J.-F. Carlotti, G. Bruguier, J. Gasiot, C. Guasch, J. Bonnet, M. Ramonda <i>Étude des dommages induits par le passage d'un ion au niveau de l'interface SiO₂/Si</i>	133
C.9	O. Pajona, C. Aupetit-Berthelemot, J.-M. Dumas <i>Influence du recess de grille sur des HEMT Métamorphiques (MHEMT) utilisés dans les liaisons Optiques 40Gbit/s</i>	135
C.10	Y. Meziani, J. Lusakowski, F. Teppe, N. Diakonova, W. Knap, K. Romanjek, M. Ferrier, R. Clerc, G. Ghibaudo, F. Skotnicki, F. Boeuf, T. Skotnicki <i>Nouvelle méthode de mesure de mobilité par magnétorésistance sur des transistors MOSFET de taille nanométrique</i>	137
C.11	O. Pajona, C. Dumas <i>De la mesure à la simulation système de transistors HEMT Métamorphiques (MHEMT) utilisés dans les liaisons optiques 40Gbit/s</i>	139

C.12	H. Maanane, M. Masmoudi, P. Bertram, J. Marcon, M. Belaid, K. Mourgues, P. Eudeline, K. Ketata <i>Caractérisation et modélisation d'un RF LDMOS de puissance dans le cadre d'une étude de fiabilité pour application radar</i>	141
C.13	M. Lijadi, P. Bove, J.-L. Pelouard <i>Transport électronique dans le TBDH InP/GaAsSb/InP</i>	143

Session Poster II 147

D	Composants optoélectroniques	147
D.1	J.-P. Perez, B. Orsal, M. Myara <i>Evaluation du rapport $\frac{P_{opt}}{P_{EB}}$ de photodétecteurs infrarouges refroidis réalisés sur $Hg_{0.7}Cd_{0.3}Te$</i>	149
D.2	J.-B. Rodriguez, P. Christol, F. Chevrier, A. Joulié <i>Superréseaux InAs/GaSb pour imagerie infrarouge multispectrale haute définition</i> .	151
D.3	D. Marris, E. Cassan, L. Vivien, S. Laval, A. Lupu, D. Pascal <i>Étude de la rapidité d'un modulateur optique à base de multipuits quantiques SiGe/Si à modulation de dopage</i>	153
D.4	M. Rouviere, M. Halbwax, C. Rambola, E. Cassan, D. Pascal, L. Vivien, D. Bouchier, S. Laval, J. Michel, J. Marc <i>Photodétecteur pour les interconnexions optiques intra puce</i>	155
D.5	F.-J. Vermersch, M. Lecomte, M. Calligaro, O. Parillaud, S. Bansropun, M. Krakowski <i>Diode laser à 852nm de forte puissance</i>	157
D.6	G. Wantz, N. Huby, L. Vignau, J. Parneix, L. Hirsch, A. Barriere <i>Effets de la température sur l'émission des diodes électroluminescentes à base de polymère</i>	159
D.7	Y. Moreau, G. Pille, J. Galy <i>Guides optiques à section transversale quelconque : un calcul scalaire et vectoriel en ligne</i>	161
D.8	G. Wantz, L. Hirsch, N. Huby, L. Vignau, A. Barriere, J. Silvain, J. Parneix <i>Influence de la morphologie de l'ITO sur les performances des diodes électroluminescentes à base de polymère</i>	163
D.9	A. Ouvrard, A. Garnache, L. Cerutti, F. Genty, D. Romanini <i>VCSELs monofréquences émettant en continu à 300K à 2,3μm appliqués à l'analyse de gaz</i>	165
D.10	L. Guilloton, S. Tedjini, T.-P. Vuong <i>Modélisation de composants optiques diffusés sur verre : Application au Fabry-Perot intégré</i>	167
D.11	D. Lauvernier, J. Harari, J.-P. Vilmot, D. Decoster <i>Guides nanophotoniques III-V/Polymère</i>	169
D.12	B. Damilano, J. Barjon, S.-W. Wan, J.-Y. Duboz, M. Leroux, S. Laügt, J. Massies, A. Hierro, J.-M. Ulloa <i>Applications optoélectroniques de (Ga,In)(N,As) sur substrat de GaAs : des cellules solaires aux diodes lasers</i>	171
D.13	J.-Y. Bengloan, S. Dhillon, M. Calligaro, C. Sirtori <i>Réduction de la densité de courant de seuil à température ambiante dans les lasers à cascade quantique en GaAs grâce à l'utilisation de couche de confinement en $Al_{0.45}Ga_{0.55}As$</i>	173
D.14	A. Martinez, V. Sallet, K. Merghem, L. Ferlazzo, J.-C. Harmand, A. Ramdane, J.-G. Provost, B. Dagens, J. Landreau, O. Le Gouezigou, S. Bonnefont, O. Gauthier-Lafaye, M. Boutillier, B. Messant, F. Lozes-Dupuy, X. Marie <i>Caractéristiques hautes fréquences de diodes lasers à base de d'alliage GaInNAs/GaAs émettant à 1,35 μm</i>	175
D.15	S. Yiou, J.-Y. Bengloan, S. Dhillon, A. De Rossi, X. Marcadet, C. Sirtori <i>Optique non linéaire dans les lasers à cascade quantique</i>	177

D.16	S. Dhillon, C. Sirtori, A. De Rossi, S. Bansropun, M. Calligaro, X. Marcadet <i>Influence de la profondeur de gravure sur les performances de lasers à cascades quantiques sur GaAs</i>	179
D.17	P. Gilet, E. Pougeoise, L. Grenouillet, N. Dunoyer, P. Duvaut, P. Grosse, A. Million <i>Vers un VCSEL 1.31 μm sur substrat GaAs</i>	181
D.18	N. Huby, G. Wantz, L. Vignau, L. Hirsch, A.-S. Barrière, L. Aubouy, P. Gerbier <i>Nouveaux composés moléculaires pour diodes électroluminescentes organiques</i> . . .	183
D.19	L. Gendron, M. Carras, A. Huynh, V. Ortiz, C. Koeniguer, V. Berger <i>Quantum cascade photodetection</i>	185
D.20	C. Bringer, V. Bardinal, E. Daran, T. Camps, G. Almuneau, C. Amat, P. Dubreuil, J.-B. Doucet, C. Fontaine <i>Détection latérale intégrée pour le contrôle de l'émission d'un VCSEL</i>	187
D.21	J. Valentin, S. Fourment, O. Bouchard, P. Arguel, F. Lozes-Dupuy <i>Capteur monolithique de déphasage optique</i>	189
D.22	A. Kazmierczak, M. Briere, P. Rojo-Romeo, J. O'Connor, X. Letartre, F. Gaffiot, R. Orobitchouk, T. Benyatou, E. Picard, B. Cluzel <i>Conception et caractérisation de composants passifs pour l'optique intégrée</i>	191
D.23	A. Vicet, A. Salhi, Y. Rouillard, J. Angellier, A. Ouvrard, C. Alibert <i>Diodes lasers mono fréquence, fonctionnant en régime continu à température ambiante et au delà, pour la détection de traces de gaz dans le moyen infrarouge</i> . . .	193
D.24	A. Salhi, Y. Rouillard, A. Vicet, P. Grech <i>Diodes laser à base de GaSb émettant entre 2 et 2,7 μm</i>	195
D.25	L. Cerutti, A. Garnache, A. Ouvrard, M. Garcia, F. Genty <i>Microcavité VCSEL émettant à 2,36 μm en continu et à température ambiante</i> . .	197
E	Dispositifs (opto)électroniques pour les télécommunications	199
E.1	P. Signoret, M. Myara, J.-P. Tourrenc, B. Orsal, J. Jacquet <i>Influence de la zone de Bragg sur le spectre optique des lasers accordables à DBR émettant autour de 1.55 μm</i>	201
E.2	M. Myara, P. Signoret, J.-P. Tourrenc, J.-P. Perez, B. Orsal, J. Jacquet <i>Bruit électrique fortement sous-poissonien dans les lasers accordables à DBR émettant autour de 1.55 μm</i>	203
E.3	A. Guermache, V. Voiriot, N. Bouche, D. Locatelli, F. Legrand, B. Ligat, R.-M. Capella, J. Jacquet <i>Laser de pompe pn/BH 1.48 μm à guide MMI 1×1 actif</i>	205
E.4	C. Levallois, A. Lecorre, S. Loualiche <i>Laser à cavité verticale accordable en longueur d'onde</i>	207
E.5	O. Ostinelli, W. Bächtold, G. Almuneau, A. Rocher <i>Croissance par EPVOM de miroirs de Bragg AlGaAsSb/InP à 1,55 μm</i>	209
E.6	M. Le Du, J.-C. Harmand, J.-L. Oudar <i>Absorbant saturable innovant sur GaAs pour la régénération optique à haut débit en environnement WDM</i>	211
E.7	D. Massoubre, G. Aubin, J.-L. Oudar <i>Composant tout-optique à très faible énergie de commutation pour application à la régénération optique des signaux de télécommunication</i>	213
E.8	M. Kurdi, A. Bousseksou, S. Bouchoule, I. Sagnes, M. Strassner, A. Plais, J. Jacquet, K. Merghem, M. D. Salik <i>Sources laser à cavité verticale externe pompées électriquement sur InP pour l'émission à 1,55 μm (EP-VECSEL)</i>	215
E.9	C. Platz, P. Caroff, C. Paranthoën, G. Moreaux, N. Bertru, A. Le Corre, H. Folliot, C. Labbé, O. Dehaese, S. Loualiche, A. Ponchet <i>Lasers à îlots quantiques InAs/InP émettant à 1.55 μm pompés électriquement</i> . . .	217
E.10	X. Chécoury, P. Boucaud, J.-M. Lourtioz, S. Bonnefont, D. Mulin, J. Valentin, L. Cissé, O. Gauthier-Lafaye, F. Lozes-Dupuy, F. Pommereau, C. Cuisin, E. Derouin, O. Drisse, L. Legouezigou, F. Lelarge, F. Poingt, G.-H. Duan, A. Talneau <i>CRISTEL : Étude de lasers à cristaux photoniques pour les télécommunications optiques</i>	219

E.11	S. Huyghe, L. Béchou, Y. Danto, D. Laffitte, A. Denolle, C. Ollivier, D. Keller, M. Renaud <i>Fiabilité des amplificateurs optiques à semiconducteur 1.55μm. Analyse expérimentale et modélisation physique</i>	221
Session Poster III		225
F	Micro et nanotechnologie	225
F.1	B. Ilahi, L. Sfaxi, L. Bouzaïene, F. Hassen, H. Maaref, G. Bremond, G. Guillot <i>Optimisation de l'espaceur des structures à empilement de plans de boîtes quantiques InAs/GaAs</i>	227
F.2	L. Chusseau, P. Lefebvre, T. Bretagnon, B. Gil <i>Évidence de l'interaction dipôle-dipôle dans la photoluminescence résolue en temps de boîtes quantiques de GaN/AlN</i>	229
F.3	P. Lefebvre, T. Bretagnon, T. Taliercio, T. Guillet, B. Gil, N. Grandjean, B. Damilano <i>Malices et fourberies des boîtes quantiques GaN/AlN</i>	231
F.4	C. Symonds, J. Mangeney, I. Sagnes, G. Saint-Girons, K. Meunier, S. Bouchoule <i>Réduction de la durée de vie des porteurs dans un puits quantique près de la surface</i>	233
F.5	N. Chauvin, B. Salem, T. Benyattou, C. Bru-Chevallier, G. Guillot, G. Bremond, C. Monat, P. Rojo-Romeo, M. Gendry <i>Propriétés optiques individuelles d'îlots quantiques d'InAs/InP(001)</i>	235
F.6	S. Collin, F. Pardo, R. Teissier, J.-L. Pelouard <i>Nanostructures métalliques pour la photodétection ultrarapide</i>	237
F.7	J. Dion, J.-L. Pelouard, D. Bensahel <i>Report de dispositifs III-V par brasure AuIn₂</i>	239
F.8	T. Minea, S. Point, M.-P. Besland, A. Granier <i>Comparaison structurale entre NTC dopés N et nanofibres de CNx synthétisés par PECVD</i>	241
F.9	A. Turala, B. Laine, P. Regreny, M. Besland, P. Rojo-romeo, M. Gendry <i>Nanopatterning d'InP pour la localisation de boîtes quantiques d'InAs</i>	243
F.10	M. Marchetti, E. Nativel, P. Falgayrettes, D. Gasquet, M. Castagne, P. Gall-Borrut <i>Sondes microniques pour la caractérisation en champ proche de MMICs</i>	245
F.11	F. Mailly, G. Ferblantier, F. Pascal-Delannoy, P. Combette, A. Giani, A. Foucaran <i>Étude du dépôt d'oxyde de zinc pour la fabrication de résonateurs à ondes acoustiques de volume</i>	247
G	Structures de basse dimensionnalité	249
G.1	C. Hernandez, F. Terki, S. Charar, J. Sadowski, D. Maude <i>Propriétés magnétiques de couches minces et de superréseaux à base de GaMnAs étudiées à basse température et fort champ magnétique</i>	251
G.2	S. Olivier, L. Grenouillet, P. Duvaut, P. Gilet, J.-M. Gerard <i>Sources de photons uniques pour la cryptographie quantique</i>	253
G.3	R. Melet, G. Christmann, V. Voliotis, R. Grousson, X. L. Wang, M. Ogura <i>Excitons chargés dans un fil quantique semiconducteur</i>	255
G.4	N. Cavassilas, M. Bescond, J.-L. Autran <i>Transport quantique dans un transistor contraint</i>	257
G.5	M. Bescond, J.-L. Autran, N. Cavassilas, K. Nehari, L. Raymond, D. Munteanu, M. Lannoo <i>Simulation quantique 3D d'un MOSFET Gate-All-Around</i>	259
G.6	Y. Jin, D.-Y. Cong, A. Elhdiy, B. Etienne, U. Gennser, A. Canvanna <i>Transistor balistique à contact ponctuel quantique</i>	261
H	Microcavités et bandes interdites photoniques	263
H.1	R. Saoudi, P. Moretti, B. Jacquier, H. Rigneault, M. Cathelinaud, E. Nichelatti, R. M. Montereali, F. Somma <i>Nouvelle méthode d'élaboration de microcavité optique active par implantation ionique dans du LiF</i>	265

H.2	S. Sanchez, C. De Matos, M. Pugnet <i>Modulation tout-optique via les non-linéarités dues aux états liés dans les semiconducteurs en microcavité</i>	267
H.3	D. Neel, T. Benyattou, R. Orobitchouk, J. Fedeli <i>Démultiplexeurs en longueur d'onde à base de cristaux photoniques</i>	269
H.4	B. Benbakir, H. Hattori, J. Mouette, J.-L. Leclercq, C. Seassal, X. Letartre, P. Rojo-Romeo, P. Viktorovitch <i>Association de MOEMS et de Cristaux Photoniques bidimensionnels : Microphonique 2.5D</i>	271
I	Composants et technologie THz	273
I.1	Y. Todorov, C. Minot, I. Abram <i>Calcul théorique sur l'émission spontanée d'un dipôle proche d'un réseau métallique rectangulaire</i>	275
I.2	M. Sirbu, F. Aniel, S. Lepaul <i>Couplage des équations de Maxwell et Boltzmann, en 3D, dans le cas d'un photocommutateur</i>	277
I.3	P. Mounaix, M. Tondusson, L. Sarger, J.-L. Lorriaux, K. Blary, C. Coinon, J.-F. Lampin <i>Caractérisation ultra haute fréquence de la permittivité complexe de matériaux par spectroscopie THz</i>	279
I.4	H. Eusèbe, J.-F. Roux, F. Garet, J.-L. Coutaz, A. Krotkus, K. Bertulis <i>Modélisation et caractérisation de photocommutateurs ultrarapides en GaAs BT dopé Be</i>	281
I.5	N. Diakonova, J. Lusakowski, Y. Meziani, W. Knap, T. Parenty, S. Bollaert, A. Cappy <i>Influence of magnetic field on the terahertz radiation from nanometer InGaAs/-AlInAs HEMTs</i>	283
I.6	N. Chimot, L. Joulaud, J. Mangeney, P. Crozat, K. Blary <i>Photoconducteurs ultra-rapides (2 ps) avec commande optique à 1,55 μm</i>	285
I.7	H. Némec, F. Garet, L. Duvillaret, J.-L. Coutaz, P. Kužel <i>Filtres passe-bande agiles dans le domaine THz</i>	287
I.8	A. Akwoué Ondo, L. Chusseau, J. Jacquet <i>Génération à 1,55 μm d'un battement accordable jusqu'à 1 THz pour la synchronisation d'un oscillateur Téraherzt</i>	289
I.9	L. Joulaud, J. Mangeney, N. Chimot, P. Crozat, G. Fishman <i>Diffusion dipolaire des porteurs libres dans l'InGaAs irradié par des ions</i>	291

